

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING TAHUN KE-2**



Dibiayai oleh DIPA UPI sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing lanjutan dengan SK Rektor UPI No. 2784/H.40/PL/2009 Tanggal 7 Mei 2009

**PENUMBUHAN MATERIAL DMS GaN:Mn DAN STRUKTUR
GaN/GaN:Mn DI ATAS SUBSTRAT SILIKON DENGAN
METODE PA-MOCVD UNTUK APLIKASI DIVAIS MTJ**

Peneliti:

Aip Saripudin, M.T. (Ketua)
Dr. Budi Mulyanti (Anggota)
Pepen Arifin, Ph.D (Anggota)

**JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2009**

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PENUMBUHAN MATERIAL DMS GaN:Mn
DAN STRUKTUR GaN/GaN:Mn DI ATAS
SUBSTRAT SILIKON DENGAN METODE
PA-MOCVD UNTUK APLIKASI DIVAIS MTJ

Program Payung Penelitian : Material Elektronika

Lama Penelitian : 1 tahun

Peneliti Utama : Aip Saripudin, M.T.

Unit Kerja : FPTK UPI

Alamat Kantor : Jl. Dr. Setiabudi 229 Bandung

Nama Anggota Peneliti : 1. Dr. Budi Mulyanti
2. Pepen Arifin, Ph.D.

Biaya Penelitian : Rp 40.000.000,- (Hibah Bersaing Tahun ke-2)

Sumber Dana : DIPA UPI
SK Rektor No. 2784/H.40/PL/2009

Bandung, 30 Nopember 2009

Mengetahui:

Dekan,

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. H. Mukhidin, M.Pd.

NIP. 19531110 198002 1 001

Aip Saripudin, M.T.

NIP. 19700418 200501 1 001

Mengetahui:

Ketua LPPM UPI,

Prof. Dr. H. Soemarto, MSIE

NIP. 19550705 198103 1 005